

专利号:200610024095
[\[主 附 图\]](#)
[\[公开说明书\]](#)
[\[授权说明书\]](#)

- ▣ [钱眼网首页](#)
- ▣ [钱眼专利首页](#)
- ▣ [发送留言](#)
- ▣ [收藏这个专利](#)

掺稀土元素氧化镓荧光衬底材料及其制备方法

摘 要

一种用作GaInN基蓝光半导体外延生长的掺稀土元素氧化镓荧光衬底材料及其制备方法。该掺稀土元素的氧化镓荧光衬底单晶体的分子式为： $\beta\text{-Ga}_{1-2x}(\text{RE})_x\text{O}_3$ ，其中RE=Ce或Tm， $x=0.001\sim 0.1$ 。该晶体采用浮区法进行生长。该荧光衬底适合于外延生长高质量GaInN基蓝光半导体薄膜，与GaInN基蓝光相结合能实现发光二极管的白光发射。

权利要求

掺稀土元素氧化镓荧光衬底材料及其制备方法

一种掺稀土元素的氧化镓荧光衬底单晶体，其特征在于该衬底单晶体的分子式为： $\beta\text{-Ga}_{1-2x}(\text{RE})_x\text{O}_3$ ，其中RE为铈Ce或铕Tm， $x=0.001\sim 0.1$ 。[中国科学院上海光学精密机械研究所](#)



▣ 相关业务范围 NEW

- [我要申请专利](#)
- [我要申请商标](#)
- [版权业务](#)
- [知识产权海关保护](#)
- [诉讼代理](#)
- [企业顾问](#)

[更多>>](#)

详细介绍

投资有风险，请您关注我们为您提供的[专利咨询服务](#)

专利号:	200610024095
申请日:	2006年2月23日
公开/公告日:	2006年9月13日
授权公告日:	
申请人/专利权人:	中国科学院上海光学精密机械研究所
国家/省市:	上海(31)
申请人地址:	上海市800-211邮政信箱
邮编:	201800

发明/设计人:	夏长泰、张俊刚、徐军、周国清、吴锋、裴广庆、吴永庆
代理人:	张泽纯
专利代理机构:	上海新天专利事务所(31213)
专利代理机构地址:	上海市复兴中路526号503室(200020)
专利类型:	发明
公开号:	1831084
公告日:	
授权日:	20
公告号:	0000000
优先权:	
审批历史:	
附图数:	1
页数:	8
权利要求项数:	2

[请进入中国专利检索数据库核实](#)

[点击进入](#)

对该专利感兴趣:

姓名

电话/邮箱 (不显示)

专利分类: [生活及医学](#) · [作业及运输](#) · [化学及冶金](#) · [纺织及造纸](#) · [建筑及采矿](#) · [机械及工程](#) · [物理及测量](#) · [电子及通讯](#)

[关于钱眼](#) | [服务指南](#) | [欢迎合作](#) | [联系我们](#) | [免责声明](#)

[将钱眼设为首页](#) | [将钱眼推荐给朋友](#)

钱眼网 版权所有 Copyright ©2011 Qianyan.biz All rights reserved. | 网络实名: 钱眼

网站咨询热线: **010-86084543** E-Mail: qianyan.biz@hotmail.com QQ: 532008814